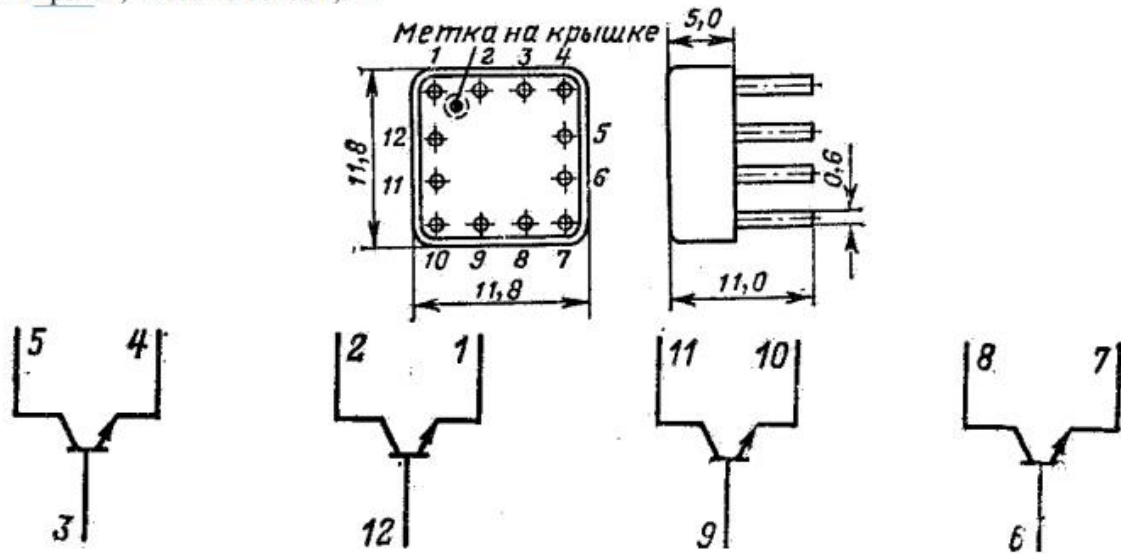


201НТ1 (2НТ011), 201НТ2 (2НТ012), 201НТ3 (2НТ013), К201НТ1 (К2НТ011), К201НТ2 (К2НТ012), К201НТ3 (К2НТ013)

Микросхемы представляют собой сборку из четырех п-р-п транзисторов. Корпус металлополимерный штырьковый «Тропа», масса не более 1,5 г.



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	< 0,3 В
Обратный ток коллектора	< 5 мкА
Коэффициент передачи по току	
201НТ1	> 22
К201НТ1	> 13
201НТ2	> 31
К201НТ2	> 22
201НТ3	> 70
К201НТ3	> 35

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-эмиттер	5 В
Ток коллектора	15 мА
Рассеиваемая мощность одного транзистора	< 15 мВт
Температура окружающей среды	
201НТ1,2,3	-60...+70°C
К201НТ1,2,3	+1...+50°C (по некоторым источникам -10...+55°C)
Относительная влажность воздуха при +40°C	до 98%
Атмосферное давление (201НТ1,2,3)	6,7x10 ² ...3x10 ⁵ Па
Вибрационные нагрузки	
201НТ1,2,3 (5-5000 Гц)	до 40 g
К201НТ1,2,3 (5-600 Гц)	до 5 g
Многократные удары с ускорением	
201НТ1,2,3	до 150 g
К201НТ1,2,3	до 15 g
Линейные нагрузки с ускорением	
201НТ1,2,3	до 150 g
К201НТ1,2,3	до 25 g
Одиночные удары с ускорением (201НТ1,2,3)	до 1000 g